

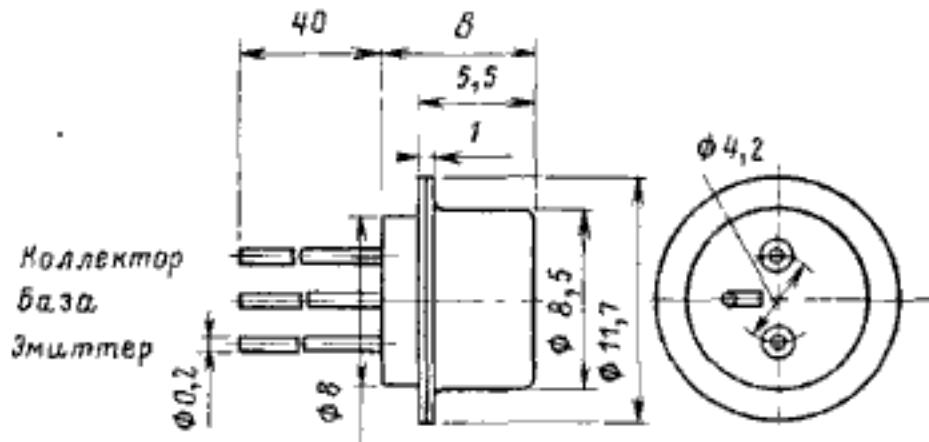
1T116А, 1T116Б, 1T116В, 1T116Г

Транзисторы германиевые сплавные $p-n-p$ переключающие ма-
домощные

Предназначены для работы в формирователях и усилителях импульсов, мультивибраторах и других переключающих схемах

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 2 г



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_K = 100$ мА, $t_u = 10$ мкс, $Q \geq 50$

при $T = 293$ К

IT116A, IT116B, IT116Г	15-65
IT116В	20-65

при $T = 213$ К и $T = 343$ К

IT116A, IT116B, IT116C	12-80
IT116B	16-80

Время нарастания при $U_{\text{КБ}} = 12,6$ В, $U_{\text{БЭ}} = 0,3$ В,

$$\tau_w = 1.5 - 4 \text{ msec}, f = 30 \text{ kHz}$$

при $R_{БЭ} = 51$ Ом 1T116A, 1T116B 0,28–0,63 мкс

при $R_{\text{вн}} = 0, 10, 27 \text{ Ом}$ 1T116B, 1T116Г 0,28 – 0,63 мкс

Время спада при $U_{КБ} = 12,6$ В, $U_{БЭ} = 0,3$ В, $\tau_k = 1,5 \div 4$ мкс, $f = 30$ кГц:

при $R_{B3} = 51$ Ом IT116A, IT116Б 0,6–2 мкс

при $R_{63} = 0, 10, 27$ Ом 1T116B, 1T116Г 0,6–2 мкс

Границная частота коэффициента передачи тока в схеме с общей базой при $U_{KB} = 5$ В, $I_K = 1$ мА не менее . . .

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K =$

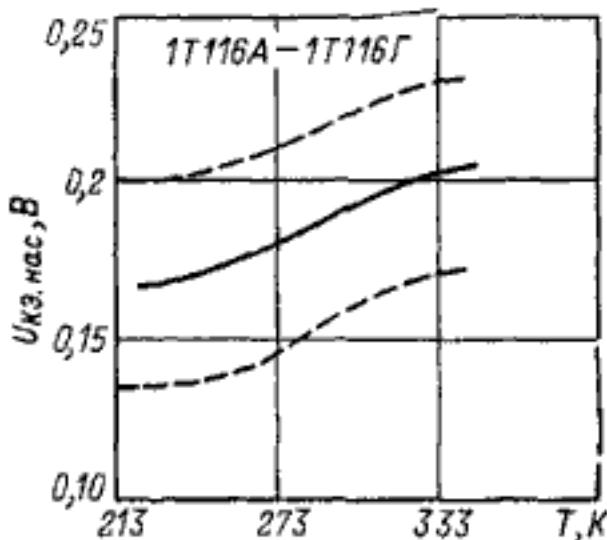
$= 150$ мА, $I_B = 30$ мА не более 0,25 В

Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{K3} = 15$ В,

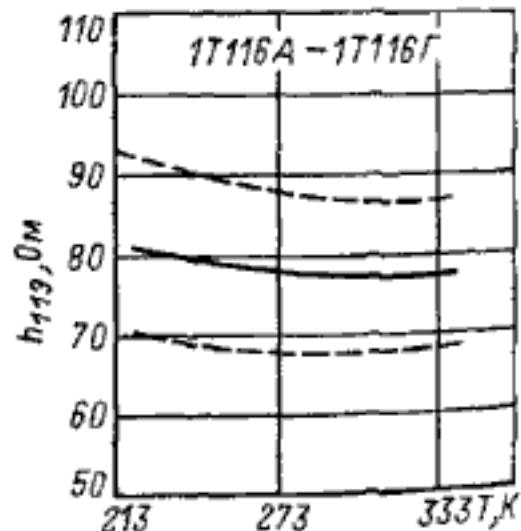
$U_{БЭ} = 0,5$ В не более:

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 550$ Ом	15 В
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 550$ Ом, $\tau_n \leq 5$ мкс	30 В
Импульсное напряжение эмиттер-база при $\tau_n \leq 5$ мкс	18 В
Импульсный ток коллектора при $\tau_n \leq 5$ мкс, $Q \geq 6$:	
при $T = 213 \div 293$ К	300 мА
при $T = 333$ К	250 мА
при $T = 343$ К	150 мА
Постоянный ток коллектора при $T = 293$ К	50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
при $T = 213 \div 308$ К	150 мВт
при $T = 343$ К	75 мВт
Температура перехода	358 К
Температура окружающей среды	От 213 до 343 К



Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения коллектор-эмиттер от температуры.



Зона возможных положений зависимости входного сопротивления от температуры.